

定位成長石墨烯之技術

本院覽號

26A-1010224

公告日期

智財權狀態

台灣(發明)I526559放棄維護、美國已申請

摘要

在金屬基板底下會形成石墨烯薄膜，我們運用此特性，成功的運用標準的光學顯影方式達成石墨烯定位成長的目標，此技術避免了需實驗技巧的石墨烯取下及再次覆蓋的步驟，此技術可應用在次世代透明導電電極及高速元件的製作。

技術優勢

此技術避免了需高度實驗技巧的石墨烯取下及再次覆蓋的步驟，同時可運用標準的光學顯影方式達成石墨烯定位成長的目標。

應用範圍

半導體產業

發光二極體產業

創作人

林時彥、林孟佑、陳書涵



中央研究院
ACADEMIA SINICA